

## 製品概要

### FDMS0312AS: N チャンネル PowerTrench® SyncFET™ 30V、22A、5.0mΩ

技術情報は、データシートをご参照ください。

FDMS0312AS は電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。シリコン技術およびパッケージ技術の両方の進歩が組み合わせられ、最低の  $rDS(on)$  を実現しながら、卓越したスイッチング性能を維持します。このデバイスには、効率的なモノリシックショットキーポダイオードという利点があります。

### 特長

- 最大  $rDS(on) = 5.0\text{ m}\Omega$  @  $V_{GS} = 10\text{ V}$ 、 $I_D = 18\text{ A}$
- 最大  $rDS(on) = 6.2\text{ m}\Omega$  @  $V_{GS} = 4.5\text{ V}$ 、 $I_D = 16\text{ A}$
- 低い  $rDS(on)$  と高効率のための高度なパッケージとシリコンの組み合わせ
- SyncFET ショットキーポダイオードが含まれています
- MSL1 堅牢パッケージ設計
- UIL 100% テスト済み
- RoHS 対応

### アプリケーション

- Notebook PC

### 電氣的仕様

製品	Pricing (\$/Unit)	Compliance	Status	Channel Polarity	Configuration	$V_{DS}^{(BR)}$ Min (V)	$V_{GS}^{Max}$ (V)	$V_{GS}^{(th)}$ Max (V)	$I_D^{Max}$ (A)	$P_D^{Max}$ (W)	$R_{DS(on)}^{n)}$ Max @ $V_{GS} = 2.5\text{ V}$ (mΩ)	$R_{DS(on)}^{n)}$ Max @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$ (mΩ)	$R_{DS(on)}^{n)}$ Max @ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (mΩ)	$Q_3^{Typ}$ @ $V_{GS} = 4.5\text{ V}$ (nC)	$Q_3^{Typ}$ @ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (nC)	$C_{iss}^{Typ}$ (pF)	Package Type
FDMS0312AS	0.1879	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	N-Channel	Single	30	20	3	22	36	-	6.2	5	-	11	1365	PQFN-8

詳細は、弊社 [www.onsemi.jp](http://www.onsemi.jp) の営業または販売代理店にお問い合わせください。

9/21/2021 作成